

단원자층 증착장비 개발 MOU

비밀

경기도 평택시 지재동 33번자 소재의 (주)아이피에스 (이하 'IPS'라 함)와 서울시 성동구 행당동 17번지 소재의 한양대학교 (이하 '한양대'라 함)는 2004년12월에 양자 간에 체결한 '단원자층 증착장비 개발협약서' (이하 '협약서'라 함)의 연장선상에서 다음과 같이 MOU를 체결한다.

제 1 조 (MOU의 목적)

본 MOU는 '협약서' 제3조③항 ("연장이 필요하다고 쌍방이 인정할 경우, 한양대와 IPS는 연장 기간에 대해 협의할 수 있다.")에 따라 계약기간을 1년간 연장하며, 또한 관련 기술의 실시에 대한 기본 원칙을 규정함을 그 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

- ① "관련 기술"이라 함은 본 MOU의 수행을 위해 한양대가 IPS에 제공한/할 기술적 사실, 데이터, 실험자료 및 결과, 아이디어, 기술적 사양, Knowhow, 영업비밀, 보고서를 포함하는 일체의 정보자료를 말한다.
- ② "개발"이라 함은 IPS가 ALD 장비 개발에 대하여 수행하는 Engineering, 분석, 실험 및 데이터 처리, 소프트웨어 제작, 샘플제작 및 성능개선을 포함하는 일체의 활동을 말한다.
- ③ "개발결과물"이라 함은 본 MOU를 수행하여 얻어진 특허권, 실용신안권, 의장권, 소프트웨어, 저작권, 영업비밀, Knowhow를 포함하는 일체의 결과물을 말한다.
- ④ "기술료"라 함은 '협약서' 및 본 MOU의 수행에 의해 획득한 기술에 대해 한양대의 기여 부분에 상응하여 IPS가 한양대에 지불하는 소정의 금액을 말한다.

제 3 조 (개발범위 및 개발기간)

- ① 본 MOU상의 개발범위는 Remote Plasma ALD 장비 및 그 장비를 이용한 ALD 공정 기술로 규정한다.
- ② 본 MOU상의 개발기간은 2005년12월1일부터 2006년11월30일까지의 1년간으로 한다.
- ③ 연장이 필요하다고 쌍방이 인정할 경우, 한양대와 IPS는 연장 기간에 대해 협의할 수 있다.

제 4 조 (관련 기술의 제공)

- ① ALD 장비를 개발하는데 있어 필요로 하는 한양대 보유 관련 기술은 별첨#1 (관련 기술 List)과 같으며 이를 IPS측에 제공한다.
- ② 개발 과정에서 IPS가 추가로 요청하고 한양대가 제공 가능한 관련 기술이 있을 경우, 별첨#1에 추가로 기입하고 관련 기술을 제공한 후 이를 양자가 확인한다.
- ③ 본 개발기간 동안 한양대가 IPS에 제공한 관련 기술은 한양대의 소유이며, IPS는 제공받은 관련 기술을 ALD 장비 개발 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

제 5 조 (ALD 장비의 개발 활동)

- ① IPS는 한양대가 제공한 관련 기술을 활용하여 remote plasma ALD 장비를 개발함에 있어 IPS 자체 비용으로 개발함을 원칙으로 한다.

② IPS의 개발 활동에 한양대측의 개발인력이 참여할 수 있으며, 한양대측이 인력 참여를 요청할 경우 IPS는 특별한 사유가 없는 한 한양대측 개발인력의 참여를 허용하여야 한다.

제 6 조 (개발결과물의 귀속)

① 계약기간 중 획득한 지적 재산권에 대해서는 발명자 우선주의에 따라 양사가 각각 독자적으로 개발한 지적 재산권은 각자 독자 소유로 하며 양사가 공동으로 개발한 지적재산권은 공동 소유로 한다.

② 본 MOU 이전에 양자의 독립된 개발 결과에서 얻은 관련 기술은 각자의 단독소유로 한다.

③ 한양대의 단독소유나 양자 공동소유인 관련 기술에 대해 IPS가 최우선 실시권을 갖으며 IPS의 요청이 있을 경우 독점적 전용실시권을 허용한다.

④ IPS는 본 MOU의 종료 후 3개월 이내에 제6조3항에서 정한 실시권의 행사여부를 한양대에 서면통보하여야 한다.

⑤ IPS가 제6조3항에서 정한 실시권을 행사하고자 할 경우, 이에 대한 대가로써 한양대에 소정의 기술료를 지불하며, 이에 대한 조건은 별도의 계약의해 정한다.

제 7 조 (개발 보고회 실시)

① IPS는 ALD 장비 개발에 대한 진행상황을 한양대에 보고하되, 이를 위해 3개월마다 공식적인 보고회를 실시하도록 한다.

② IPS와 한양대는 본 MOU에 의한 개발 진행상 필요한 경우 수시로 비정기적인 회의를 갖는다.

제 8 조 (신의성실 및 상호협조)

① IPS와 한양대는 상호 신의를 갖고 본 MOU의 각 조항을 성실히 이행하여야 한다.

② IPS는 전체 개발과정에 걸쳐, 또는 관련 기술에 대해 한양대의 요청이 있을 경우 수시로 개발 내용에 대해 한양대와 협의하여야 하며, 한양대는 IPS의 요청이 있을 경우 필요한 사항에 관하여 IPS에게 협조한다.

③ 한양대는 본 MOU기간의 종료 후에도 IPS의 다른 제품에 본 MOU로 개발된 기술의 적용과 관련하여 IPS의 요청이 있을 경우 적절한 비용으로 기술자문이나 기술지원을 제공한다.

제 9 조 (비밀유지)

① IPS와 한양대는 본 MOU와 관련하여 취득한 정보에 대하여 계약기간 중이나 계약종료 후 5년 동안 상대방의 사전 동의 없이 본 MOU의 목적 외에 사용하거나 제3자에게 누설하지 못한다.

② 단, 공동의 개발결과물에 대해 학술지 논문발표 및 학회, 세미나, 학술회의에서의 발표 등과 같이 학문적 목적인 경우에는 발표 15일 전에 양자간에 통보하여 상대방의 합의를 얻어야 한다.

제 10 조 (권리의무의 양도금지)

한양대의 서면 합의 없이 IPS는 본 MOU상의 어떠한 권리와 의무도 제3자에게 양도하거나 처분할 수 없다.

제 11 조 (MOU의 해지)

① IPS 또는 한양대 양자 중 일방에게 다음 각호에 해당하는 사유가 발생한 때에는 상대방은 최고 없이 즉시 본 MOU를 해지할 수 있다.

1. 감독관청으로부터 영업정지 또는 영업면허, 영업등록 등의 취소처분을 받은 때
2. 파산절차 또는 정리절차가 시작되거나 이러한 신청이 있는 경우
3. 가압류·가처분·경매 등을 당하여 본 MOU의 목적달성이 곤란하다고 판단되는 경우

② IPS 또는 한양대 양자 중 일방이 본 MOU를 위반한 경우 상대방은 15일의 기간을 두고 이를 최고한 후 시정되지 않을 경우 본 MOU를 해지할 수 있다.

③ 한양대는 IPS가 제3조에 제시된 기간 또는 서면 합의한 연장기간에 개발을 완료하지 못하였거나 개발에 실패할 경우 본 MOU를 해지할 수 있는 권리를 갖는다.

제 12 조 (MOU의 변경)

IPS와 한양대는 서면합의에 의하여 본 MOU의 내용을 변경할 수 있다.

제 13 조 (불가항력에 의한 면책)

① IPS 또는 한양대가 화재, 홍수, 지진, 폭풍, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력에 의해 본 MOU에 기초한 의무를 이행할 수 없는 경우, 그러한 상태가 14일 이상 지속되면 상대방은 서면 통보없이 본 MOU를 해지할 수 있다.

② 이 경우에는 양자는 이행지체 또는 불이행의 책임을 부담하지 아니한다.

제 14 조 (손해배상)

IPS와 한양대가 본 MOU를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 가해자는 상대방에게 이를 배상할 의무를 가지며 배상 금액은 상호 합의하여 결정한다.

제 15 조 (MOU의 해석 및 분쟁해결)

본 MOU에 명시되지 않은 사항 및 본 MOU의 해석상의 이의가 있을 시에는 양자간의 합의로 해결하며, 본 MOU와 관련하여 또는 양자의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 양자는 이를 원만히 해결하도록 최대한 노력한다.

제 16 조 (관할법원)

본 MOU에 관련한 분쟁 해결을 위한 소송의 제기는 한양대의 주소지 관할법원에 하는 것으로 한다.

제 17 조 (MOU의 효력)

① 본 MOU는 IPS와 한양대의 양자가 기명 날인한 날로부터 유효하다.

② 본 MOU의 계약기간은 2005년12월1일부터 2006년11월30일까지의 1년간으로 한다.









제 18 조 (기타)

본 MOU는 과기부의 특정연구개발사업 처리규정을 기본으로 따르고 있으며, 본 MOU에 명시되지 않은 사항은 과기부 특정연구개발사업 처리규정에 따른다.

별첨 #1. 관련 기술 List



별첨#1.관련기술List

No	관련 기술 자료명	일 자	IPS 확인		비고
			확인자	서명	
1	Cares in designing the ICP Source	2004. 09. 10			
2	REMOTE PLASMA ALD 장비 안테나 특허 자료	2004. 11. 22			
3	purge 없는 RPALD를 이용한 TiN film 특성 결과	2004. 11. 22			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					